

Другие технологии диодов

SiC диоды

Диоды изготовлены из карбида кремния способны высокими температурами до 400 ° C. Это может быть в высокой температуре окружающей среды: нефть вниз отверстие каротажа, газотурбинные двигатели, автомобильные двигатели. Или, эксплуатации в условиях умеренной среде при высокой рассеиваемой мощности. Ядерной и космической техники обещают как SiC в 100 раз более устойчивы к радиации по сравнению с кремнием. SiC является лучшим проводником тепла, чем любой металл. Таким образом, SiC лучше, чем кремний при проведении от тепла. Пробивное напряжение в несколько кв. Устройства SiC власти должны сократить потери электрической энергии в электроэнергетике в 100 раз.

Полимерные диод

Диоды на основе органических химических веществ были получены с использованием низкой температуры процессы. Отверстие богатых и электронных полимеров богатые проводящих может быть струйных печатных слоев.

Большинство исследований и развития

органического светодиода
(OLED).

Тем не менее, развитие недорогой печати органических RFID (радиочастотная идентификация) теги идти.

В этой работе, пентацена органических выпрямитель был прооперирован в 50 МГц.

Устранение до 800 МГц цели развития.

Недорогой

металл диэлектрик металл

(MIM) диодов действует как спина к спине клипер стабилитрон был delveloped.

Кроме того, туннельный диод, как устройство было сфабриковано.